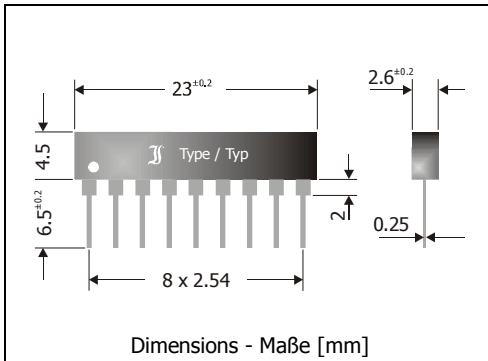


DAF811A/K ... DAF814A/K (1.2 W)**Rectifier Arrays
Gleichrichtersätze**

Version 2011-07-08



Nominal power dissipation

1.2 W

Nenn-Verlustleistung

Repetitive peak reverse voltage

100...400 V

Periodische Spitzensperrspannung

9-pin Plastic case

23 x 2.6 x 4.5 [mm]

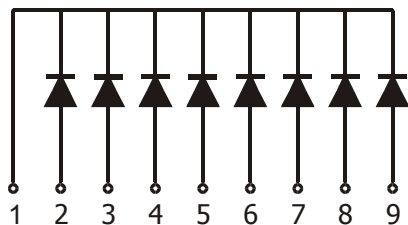
9-Pin Kunststoffgehäuse

Weight approx. – Gewicht ca.

0.6 g

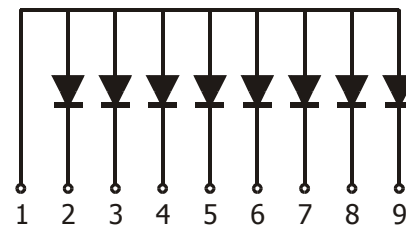
Standard packaging bulk

Standard Lieferform lose im Karton



"DAF811K...DAF814K"

common cathodes / gemeinsame Kathoden



"DAF811A...DAF814A"

common anodes / gemeinsame Anoden

Maximum ratings**Grenzwerte**

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V] ¹⁾	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V] ¹⁾
DA811A/K	100	120
DA814A/K	400	480

Max. power dissipation – max. Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}	1.2 W ¹⁾
Max. average forward rectified current, R-load for one diode operation only for simultaneous operation	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FAV} I_{FAV}	600 mA ²⁾ 150 mA ²⁾
Dauergrenzstrom in Einwegschialtung mit R-Last für eine einzelne Diode bei gleichzeitigem Betrieb beider Dioden	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FAV} I_{FAV}	600 mA ²⁾ 150 mA ²⁾
Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	30 A
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	-50...+150°C -50...+150°C

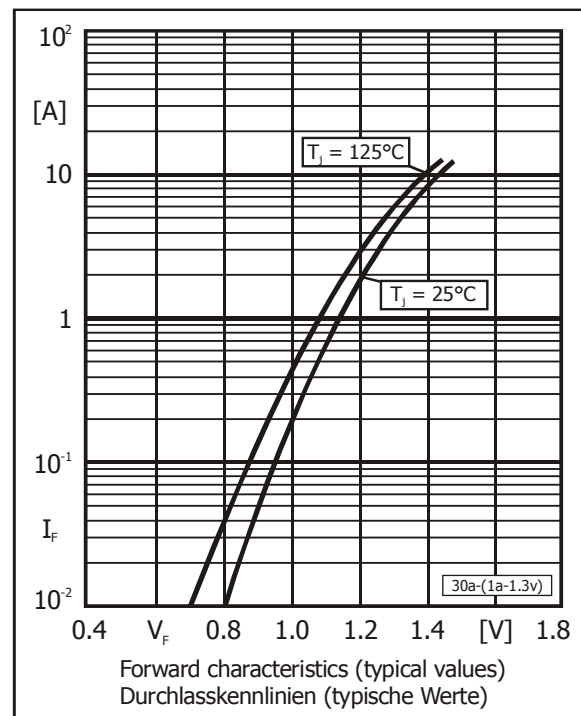
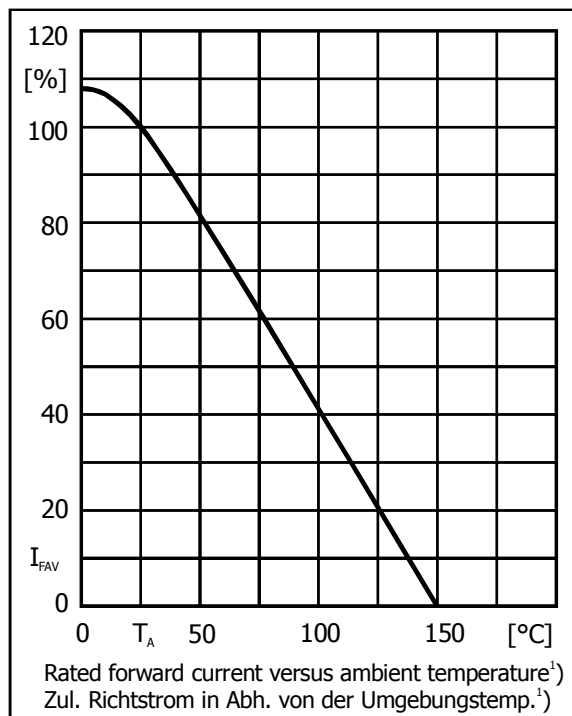
1 Per diode – Pro Diode

2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 3 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $I_F = 1\text{ A}$	V_F	$< 1.3\text{ V}^{1)}$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$ $V_R = V_{RRM}$	I_R I_R	$< 10\text{ }\mu\text{A}$ $< 90\text{ }\mu\text{A}$
Reverse recovery time Sperrverzögerung	$I_F = 10\text{ mA}$ through/über $I_R = 10\text{ mA}$ to $I_R = 1\text{ mA}$	t_{rr}	$< 350\text{ ns}$
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse		R_{thJC}	$< 85\text{ K/W}^{2)}$



1 Per diode – Pro Diode

2 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 3 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden